## 1 IGBT mold types

- High speed switching
- Voltage drive method permits low power drive
- Suited for high frequency power supplies, such as microwave ovens
- When using these IGBTs, FUJI's fast recovery diode ERD60-100 is required.
- Low saturation voltage

| Device type | $V_{CES}$ Volts | $V_{GES}$ Volts | $I_C$ cont. Amps. | $P_C$ Watts | $V_{CE}$ (sat) Max. Volts | Switching time (Max.) $t_{on}$ µsec. | $t_{off}$ µsec. | $t_f$ µsec. | Package | Net mass Grams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MBH60-090 | 900 | ±20 | 60 | 260 | 3.2 | — | — | 1.0 | TO3PL | 9.5 |
| 1MBH60-100 | 1000 | ±20 | 60 | 260 | 3.4 | — | — | 1.0 | TO3PL | 9.5 |
| 1MBH65-090 | 900 | ±20 | 65 | 260 | 3.0 | — | — | 1.0 | TO3PL | 9.5 |
| 1MBH65-100 | 1000 | ±20 | 65 | 300 | 3.2 | — | — | 1.0 | TO3PL | 9.5 |

### Fast recovery diode for IGBT

| Device type | $V_{RRM}$ Volts | $I_F$ Amps | $P_D$ Watts | $I_R$ µA | $V_F$ Volts | $t_{rr}$ µsec. | $R_{th}$ (j-c) °C/W | Package | Net mass Grams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERD60-100 | 1000 | 15 | 40 | 100 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | TO220AB | 2 |
| ERD65-090 | 900 | 30 | 50 | 100 | 1.4 | 4.4 | 2.5 | TO3PF | 6.0 |

## 2 600 volts class IGBT modules/High speed switching (L series)

- High speed switching
- Voltage drive method permits low power drive

| Device type | $V_{CES}$ Volts | $V_{GES}$ Volts | $I_C$ cont. Amps. | $P_C$ Watts | $V_{CE}$ (sat) Max. Volts | Switching time (Max.) $t_{on}$ µsec. | $t_{off}$ µsec. | $t_f$ µsec. | Package | Net mass Grams | Equivalent circuit Page 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MBI50L-060 | 600 | ±20 | 50 | 250 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.35 | M218 | 210 | Fig. 2 |
| 2MBI75L-060 | 600 | ±20 | 75 | 325 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.35 | M218 | 210 | Fig. 2 |
| 2MBI100L-060 | 600 | ±20 | 100 | 400 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.35 | M218 | 210 | Fig. 2 |
| 2MBI150L-060 | 600 | ±20 | 150 | 600 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.35 | M219 | 340 | Fig. 2 |
| 2MBI150LB-060 | 600 | ±20 | 150 | 600 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.35 | M221 | 250 | Fig. 2 |
| 2MBI200L-060 | 600 | ±20 | 200 | 800 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.35 | M219 | 340 | Fig. 2 |
| 2MBI200LB-060 | 600 | ±20 | 200 | 800 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.35 | M221 | 250 | Fig. 2 |
| 2MBI300L-060 | 600 | ±20 | 300 | 1200 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.35 | M217 | 410 | Fig. 2 |
| 2MBI300LB-060 | 600 | ±20 | 300 | 1200 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.35 | M225 | 380 | Fig. 2 |
| 2MBI400L-060 | 600 | ±20 | 400 | 1600 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.35 | M225 | 380 | Fig. 2 |
| 1MBI300L-060 | 600 | ±20 | 300 | 1200 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.35 | M116 | 415 | Fig. 1 |
| 1MBI400L-060 | 600 | ±20 | 400 | 1600 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.35 | M116 | 415 | Fig. 1 |
| 1MBI600LP-060 | 600 | ±20 | 600 | 2000 | 3.5 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | M121 | 370 | Fig. 1 |
| 1MBI600LN-060 | 600 | ±20 | 600 | 2000 | 3.5 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | M122 | 370 | Fig. 1 |

### Letter symbols

$V_{CES}$: Collector-to-emitter rated voltage (Gate-to-emitter short-circuited)
$V_{GES}$: Gate-to-emitter rated voltage (Collector-to-emitter short-circuited)
$I_C$: Rated collector current
$P_C$: Maximum power dissipation
$V_{CE}$ (sat): Collector-to-emitter saturation voltage
$t_{on}$: Turn-on time
$t_{off}$: Turn-off time
$t_f$: Fall time

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

**Данный компонент на территории Российской Федерации**

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9